

Содержание

- XXVI Международный симпозиум „Нанопизика и нанопизика“, Нижний Новгород, 14–17 марта 2022 г.

Коряжкина М.Н., Филатов Д.О., Шенина М.Е., Антонов И.Н., Круглов А.В., Ершов А.В., Горшков А.П., Денисов С.А., Чалков В.Ю., Шенгуров В.Г.

Исследование влияния оптического излучения на резистивное переключение МДП-структур на основе $ZrO_2(Y)$ на подложках Si(001) с наноструктурами Ge 723

Цыпленков В.В., Шастин В.Н.

Фотонное эхо в германии с мелкими донорами 728

Милахин Д.С., Малин Т.В., Мансуров В.Г., Кожухов А.С., Новикова Н.Н., Яковлев В.А., Журавлев К.С.

Определение толщины зародышевого слоя AlN, сформированного на поверхности $Al_2O_3(0001)$ в процессе нитридации, методами РФЭС и ИК-спектроскопии 734

Перов А.А., Пикунов П.В.

Поперечный термомагнитный эффект в двоякопериодических полупроводниковых сверхрешетках без центра инверсии 742

Зиновьев В.А., Дерябин А.С., Кацюба А.В., Володин В.А., Зиновьева А.Ф., Черкова С.Г., Смагина Ж.В., Двуреченский А.В., Крупин А.Ю., Бородавченко О.М., Живулько В.Д., Мудрый А.В.

Структурные и оптические свойства двумерных слоев Si и Ge, полученных методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках $CaF_2/Si(111)$ 748

Абросимова Н.Д., Юнин П.А., Дроздов М.Н., Оболенский С.В.

Влияние дозы имплантации водорода на релаксацию электрофизических характеристик структур „кремний-на-изоляторе“ после воздействия рентгеновского излучения 753

Шандыба Н.А., Черненко Н.Е., Балакирев С.В., Еременко М.М., Кириченко Д.В., Солодовник М.С.

Исследование влияния дозы ионно-лучевой обработки поверхности Si(111) на процессы роста нитевидных нанокристаллов GaAs 759

Коляда Д.В., Фирсов Д.Д., Тимофеев В.А., Машанов В.И., Караборчев А.А., Комков О.С.

Исследование влияния отжига и состава на инфракрасную фотолюминесценцию наногетероструктур $GeSiSn/Si$ с множественными квантовыми ямами 765

Иванов А.С., Павельев Д.Г., Оболенский С.В., Оболенская Е.С.

Радиационная стойкость источника субтерагерцового излучения после нейтронного воздействия 770

Иго А.В.

Степень поляризации комбинационного рассеяния света в нанокристаллах кремния 774

Дворецкий С.А., Ступак М.Ф., Михайлов Н.Н., Макаров С.Н., Елесин А.Г., Верхогляд А.Г.

Исследование кристаллического состояния слоев молекулярно-лучевой эпитаксии гетероструктур $(013)HgCdTe/CdTe/ZnTe/GaAs$ методом генерации второй гармоники 780

Кочаровская Е.Р., Гинзбург Н.С., Сергеев А.С., Малкин А.М., Заславский В.Ю.

Динамика широкоапертурных гетеролазеров со сбоем фазы гофрировки брэгговской структуры 788

Кузнецова И.А., Савенко О.В.

Взаимодействие электромагнитной Н-волны с полупроводниковым нанослоем 794

Осинных И.В., Александров И.А., Малин Т.В., Журавлев К.С.

Определение типов оптических переходов и концентраций доноров и акцепторов в GaN по зависимости интенсивности фотолюминесценции от мощности возбуждения 802

- Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Benkhedim H., Meradji H., Ghemid S., Bouasla A., Boumazza A. Bendjedou H., Chouahda Z., Khenata R.

First principles study of the structural, electronic, optical and thermal properties of chalcopyrite semiconductor $LiAlTe_2$ 808

- Физика полупроводниковых приборов

Лебедев А.А., Козловский В.В., Левинштейн М.Е., Малевский Д.А., Кузьмин Р.А.

Устойчивость к электронному облучению высоковольтных 4H-SiC диодов Шоттки в рабочем диапазоне температур 809

Блохин С.А., Бабишев А.В., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Блохин А.А., Бобров М.А., Кузьменков А.Г., Малеев Н.А., Андрюшкин В.В., Бугров В.Е., Гладышев А.Г., Денисов Д.В., Воропаев К.О., Жумаева И.О., Устинов В.М., Li H., Tian S.C., Han S.Y., Сапунов Г.А., Егоров А.Ю., Bimberg D.

Высокоскоростные одномодовые вертикально-излучающие лазеры спектрального диапазона 1550 нм 814

Benghorieb S., Bouhadiche A., Benzeghda S., Touam T.

Surface Plasmon Photodetectors Based on Noble Metals 824

● **Изготовление, обработка, тестирование материалов
и структур**

**Марков Л.К., Павлюченко А.С., Смирнова И.П.,
Меш М.В., Колоколов Д.С., Пушкарёв А.П.**

Исследование особенностей нанесения нанослоев Al_2O_3
методом атомно-слоевого осаждения на структурирован-
ные пленки ИТО 825